FUJI ELECTRIC

2DI 50D-050A

2-Pack BJT
600 V
50 A

パワートランジスタモジュール
POWER TRANSISTOR MODULE

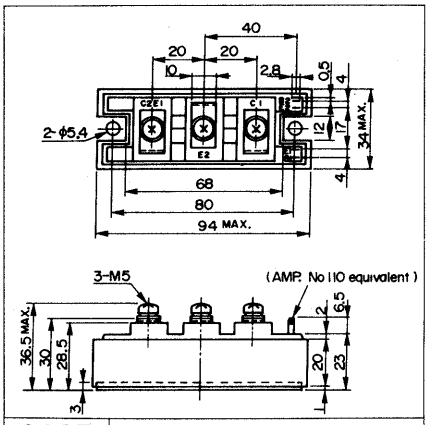
■特長：Features

- ●大電流　High Current
- ●h_{FE} が高い　High DC Current Gain
- ●絶縁形　Insulated Type

■用途：Applications

- ●大電力スイッチング　High Power Switching
- ●無停電電源装置　Uninterruptible Power Supply
- ●DC モータ制御　D.C Motor Controls
- ●溶接機　Welding Machines

■外形寸法：Outline Drawings



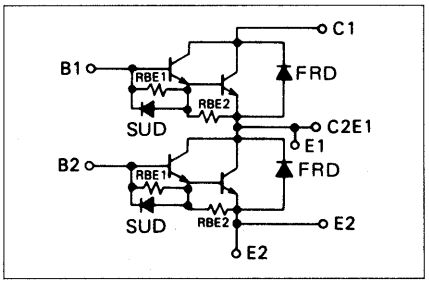
CASE	M208
UL	E82988(M)

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items		Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧		V_{CBO}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V_{CEO}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧		$V_{CEO(SUS)}$	450	V
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	DC	I_C	50	A
	1ms	I_{CP}	100	A
	DC	$-I_C$	50	A
ベース電流	DC	I_B	3	A
	1ms	I_{BP}	6	A
コレクタ損失	one Transistor	P_C	310	W
	two Transistors	P_C	620	W
接合部温度		Tj	+150	°C
保存温度		Tstg	−40～+125	°C
重量		m	175	g
絶縁耐圧	AC. 1min	Viso	2500	V
締付けトルク		Mounting ※1	35	kg·cm
		Terminals ※1	35	kg·cm

■等価回路
Equivalent Circuit Schematic



Note:
※1: 推奨値　Recommendable Value;
M5: 25～30 kg·cm

●電気的特性：Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	I_{CBO}=1mA	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	I_C=1mA	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$	I_C=1A	450			V
	$V_{CEX(SUS)}$	I_C=100A, V_{EB}=6V, $-I_{B2}$=1A	500			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	I_{EBO}=200mA	7			V
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CBO}=600V			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EBO}=7V			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C$=50A			1.5	V
直流電流増幅率	h_{FE}	I_C=50A, V_{CE}=5V	100			—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	I_C=50A, I_B=1A			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				2.5	V
スイッチング時間	t_{on}	I_C=50A, V_{CE}=300V			3.0	μs
	t_{stg}	I_{B1}=+1A, R_L=6Ω			12.0	μs
	t_f	I_{B2}=−1A			4.0	μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C$=50A, V_{BE}=−6V, $-di/dt$=50A/μs			0.6	μs

●熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.4	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Recovery Diode			1.3	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		°C/W